



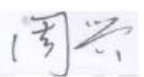
版本：200705B

规格书

3DD2102

低频放大管壳额定的双极型晶体管

适用客户：全部客户

拟制	审核	批准
 2007.5.29		



吉林华微电子股份有限公司
JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD



3DD2102 低频放大管壳额定的双极型晶体管

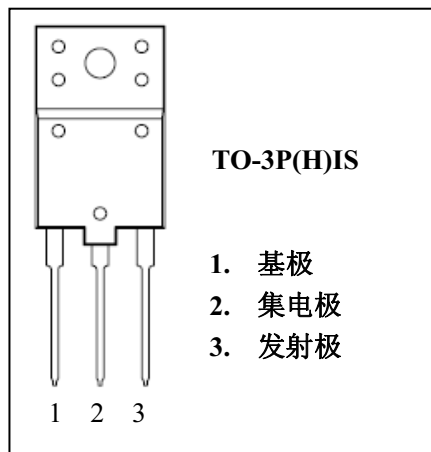
D2102

产品特性

- ◆高耐压: $V_{cbo}=1500V$
- ◆饱和压降低: $V_{ce(sat)}=5V(max.)$
- ◆高开关速度: $t_f=1\mu S(max.)$
- ◆高可靠性
- ◆ 环保 (RoHS) 产品

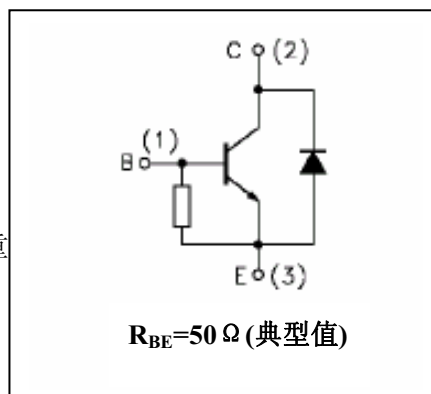
主要用途

- ◆彩色电视机行输出电路



概述

3DD2102 是 NPN 双极型高反压大功率晶体管，制造中采用的主要工艺技术有：高压台面工艺技术、三重扩散技术等，采用塑料全包封结构。



绝对最大额定值 ($T_c=25^\circ C$)

项 目	符 号	数 值	单 位
集电极—基极直流电压	V_{CBO}	1500	V
集电极—发射极直流电压	V_{CEO}	600	V
发射极—基极直流电压	V_{EBO}	6	V
最大集电极直流电流	I_c	6	A
最大集电极脉冲电流	I_{cp}	12	A
最大基极直流电流	I_b	3	A
最大集电极耗散功率	P_c	50	W
最高结温	T_j	150	$^\circ C$
贮存温度	T_{stg}	$-55\sim+150$	$^\circ C$

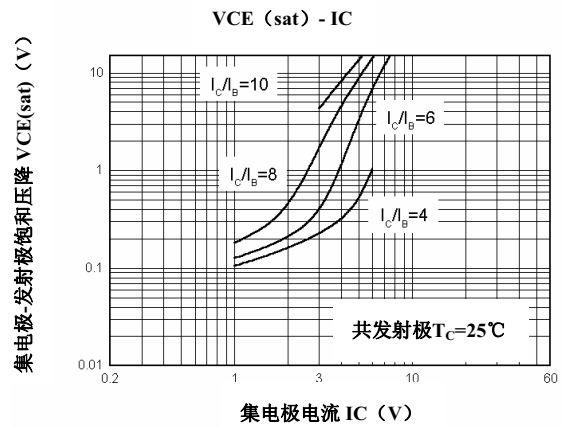
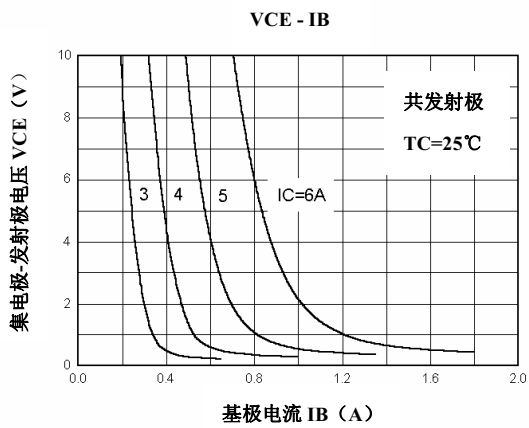
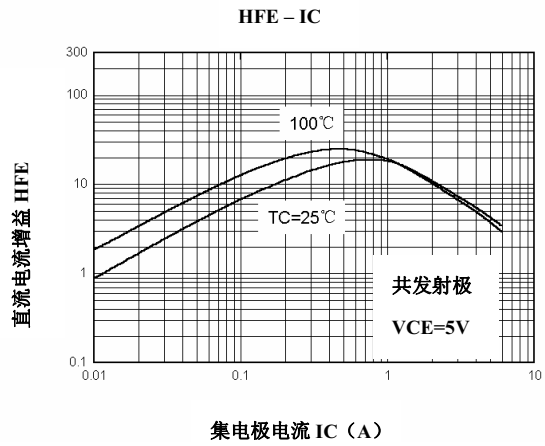
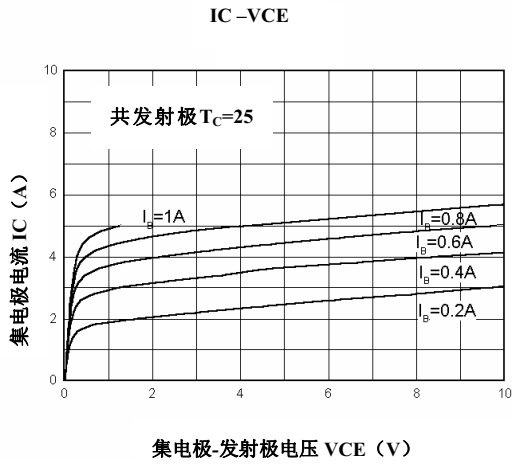


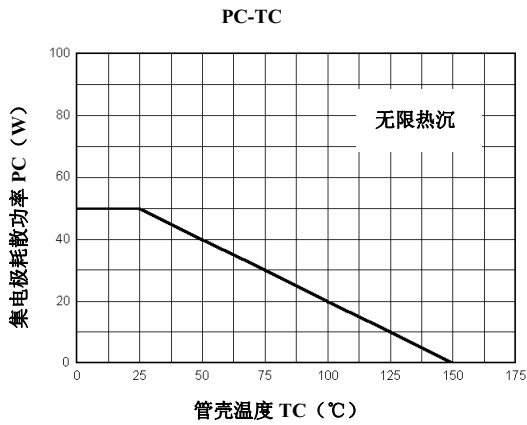
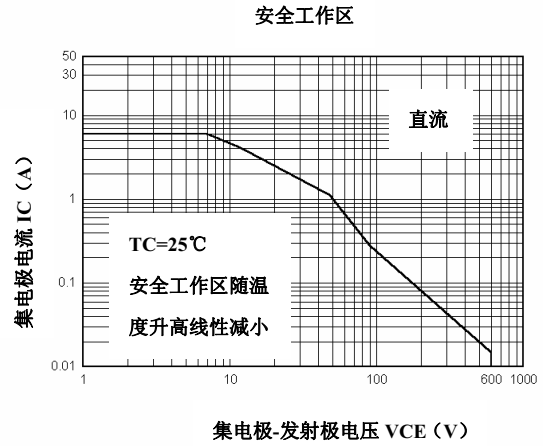
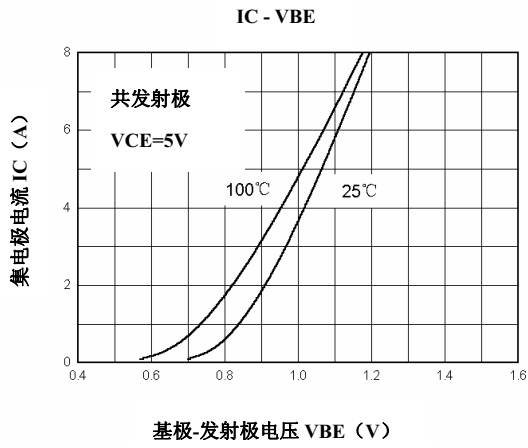
电特性 (T_c=25℃)

项 目	符 号	测试条件	最小值	最大值	单位
集电极—基极击穿电压	V(BR)CBO	I _c =1mA, I _B =0	1500		V
发射极—基极击穿电压	V(BR)EBO	I _E =400mA, I _c =0	6		V
集电极—基极反向漏电流	ICBO	V _{CB} =1500V, I _E =0		1	mA
发射极—基极反向漏电流	IEBO	V _{EB} =5V, I _C =0	66	200	mA
直流电流增益	hFE(1)	V _{CE} =5V, I _C =1A	8	30	
	hFE(2)	V _{CE} =5V, I _C =4A	5		
集电极—发射极饱和压降	V _{CE(sat)}	I _C =4A, I _B =0.8A		5	V
基极—发射极饱和压降	V _{BE(sat)}	I _C =4A, I _B =0.8A		1.5	V
阻尼二极管正向压降	-VF	I _F =5A		2	V
下降时间	t _f	I _C =4A, 2I _{B1} =-I _{B2} =1.6A f _H =15.75kHz		1	μS
贮存时间	t _s	I _C =4A, 2I _{B1} =-I _{B2} =1.6A f _H =15.75kHz		9	μS
特征频率	f _r	V _{CE} =10V, I _c =0.1A	1		MHz

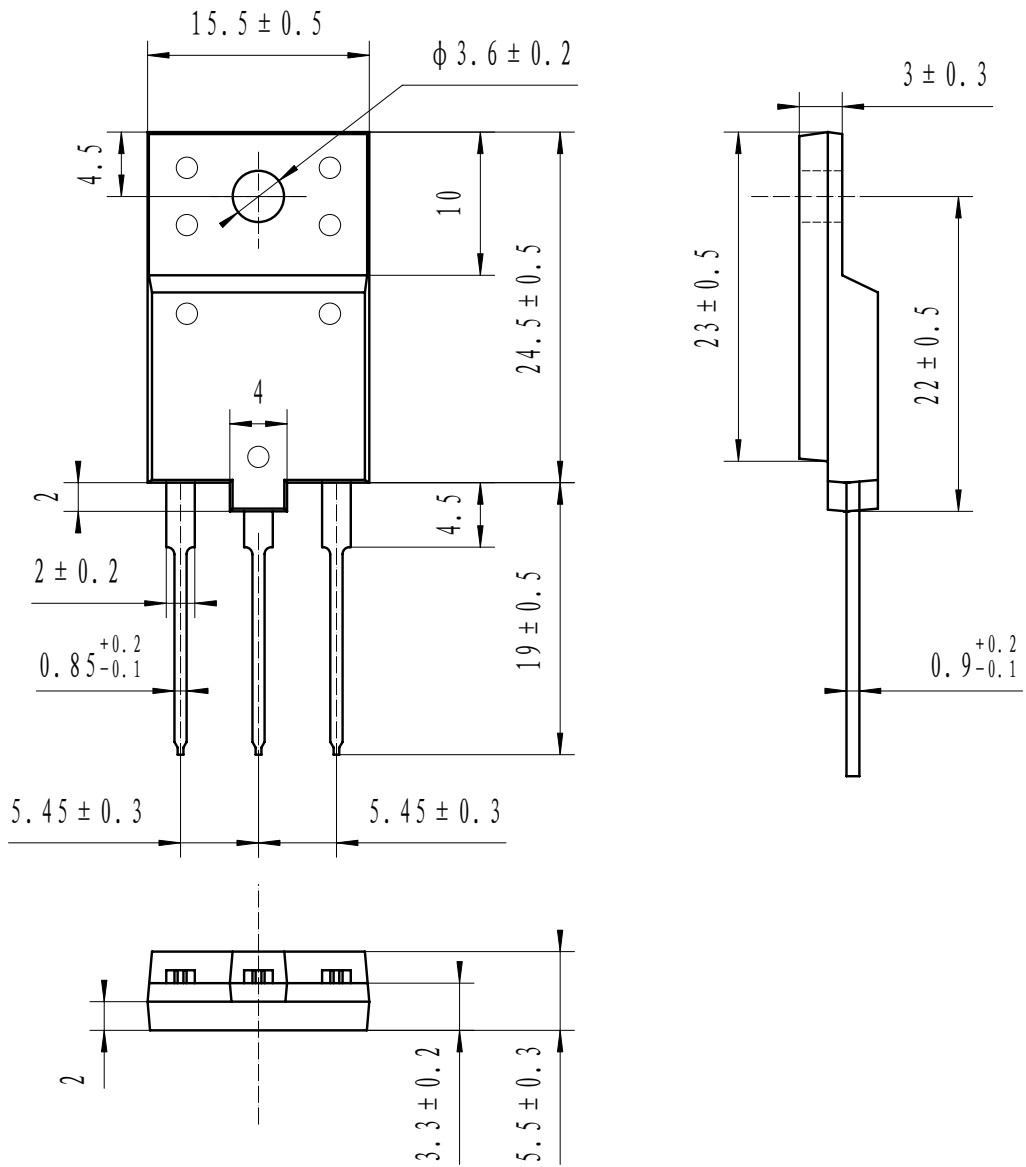


特征曲线





产品外型尺寸



单位: mm

注 意 事 项

1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理，无论哪种方式，订货时请与公司核实。
2. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
3. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
4. 如需要安装散热片时，请将器件安装在平整的散热片上。
5. 为了生产出与用户需求相匹配的产品，当有其他要求或建议时请以传真或电话的方式与公司本部联系。
6. 本说明书如有版本变更不另外告知。

联系方式

吉林华微电子股份有限公司

公司地址：吉林省吉林市深圳街 99 号，邮编：132013

总机：86-432-4678411

传真：(0432) 4665812

网址：www.hwdz.com.cn

市场营销部

吉林：

地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

电话：(0432) 4675588 4675688 (0432) 4678411-3098\3099

传真：(0432) 4671533

